



Toshiba stellt komplementären Dual-MOSFET mit 30 V vor, der kleinere, energieeffizientere Geräte für Verbraucher und Industrie unterstützt

Dual-N-Kanal- + P-Kanal-MOSFET im kompakten TSOP6F-Gehäuse mit niedrigem und ausbalancierten Einschaltwiderstand für vereinfachte Schaltungsdesigns

Düsseldorf, Deutschland, 2. Juni 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH („Toshiba“) bringt mit dem [SSM6L826R](#) einen neuen 30-V-Dual-MOSFET auf den Markt, der sowohl N-Kanal- als auch P-Kanal-MOSFETs in einem einzigen Gehäuse vereint. Diese Konfiguration eignet sich ideal für Anwendungen, u. a. Steuerung von einphasigen bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) oder von Gleichstrom-Bürstenmotoren, sowie als Lastschalter für Stromversorgungsleitungen von Industriesteuerungen.

Der SSM6L826R verwendet den UMOSVIIH-Prozess von Toshiba für den N-Kanal-MOSFET und den UMOSVI-Prozess für den P-Kanal-MOSFET. Um die Montage zu vereinfachen, ist er in einem kompakten TSOP6F-Gehäuse (2,9 × 2,8 × 0,8 mm) mit flachen Anschlüssen untergebracht.

Das Bauteil erreicht niedrige Drain-Source-On-Widerstandswerte ($R_{DS(ON)}$) von max. 46 m Ω ($V_{GS} = 10\text{ V}$) für den N-Kanal-MOSFET und max. 45 m Ω ($V_{GS} = -10\text{ V}$) für den P-Kanal-MOSFET. Da die $R_{DS(ON)}$ -Werte nahezu identisch sind, bleiben die Leitungsverluste gut ausbalanciert, was Entwicklern das Konzipieren von Schaltungsdesigns erleichtert. Darüber hinaus reduziert die Integration beider MOSFET-Typen in einem einzigen Gehäuse die Leiterplattenfläche, die Anzahl an Bauteilen und die Kosten der Materialstückliste (BOM).

Mit der Einführung des SSM6L826R erweitert Toshiba sein Portfolio an TSOP6F-Dual-MOSFETs um drei Dual-N-Kanal-MOSFETs, einen Dual-P-Kanal-MOSFET sowie zwei komplementäre N+P-MOSFETs: So haben Techniker und Ingenieure mehr Flexibilität bei der Auswahl des optimalen Bauteils für ihre Designs.

Um der wachsenden Nachfrage nach höherer Effizienz, geringeren Verlusten und weiterer Miniaturisierung von Komponenten sowohl im Verbraucher- als auch im Industriemarkt gerecht zu werden, wird Toshiba sein MOSFET-Sortiment weiter ausbauen.

Weitere Informationen zum SSM6L826R finden Sie unter: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/detail.SSM6L826R.html>

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) bietet Verbrauchern und Unternehmen in Europa eine große Auswahl an Festplattenlaufwerken (HDDs) sowie Halbleiterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Industrie, IoT, Bewegungssteuerung, Telekommunikation, Netzwerke, Consumer und Haushaltsgeräte. Neben HDDs umfasst das Angebot auch Leistungshalbleiter und andere diskrete Bauelemente von Dioden bis hin zu Logik-ICs, Optoelektronik sowie Mikrocontrollern/MCUs und anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs). Darüber hinaus bietet TEE auch SCiB™-Batteriezellen und -Module mit Lithium-Titan-Oxid (LTO) für Hochleistungsanwendungen.

TEE hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland, und verfügt über Niederlassungen in Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien, die Marketing-, Vertriebs- und Logistikdienstleistungen anbieten.

Weitere Unternehmens- und Produktinformationen finden sich auf den Websites von Toshiba unter www.toshiba.semicon-storage.com und www.scib.jp/en.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 (0) 211 5296 0
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +44 (0)7464 493526
E-Mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Pretzl
Tel: +49 (0)172 617 8431
Web: www.pretzl.com
E-Mail: birgit.schoeniger@pretzl.com